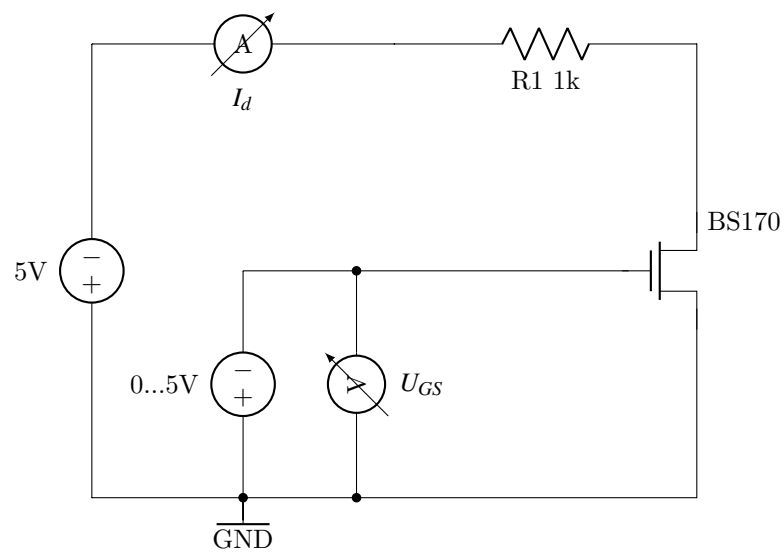
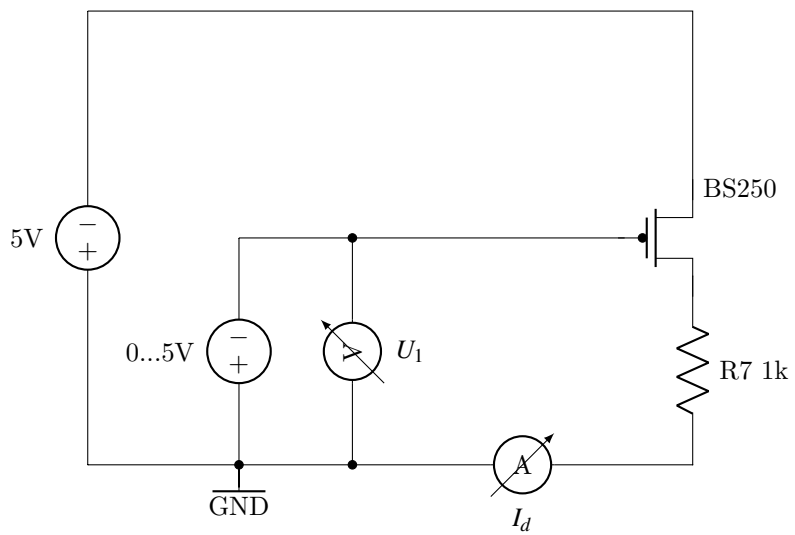


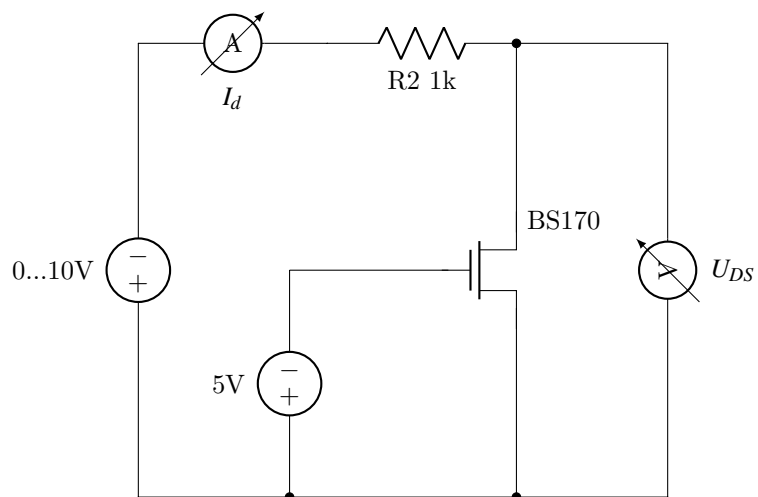
Rysunek 2: Konfiguracje stopni wzmacniających:  
a) nieodwracająca, b) odwracająca



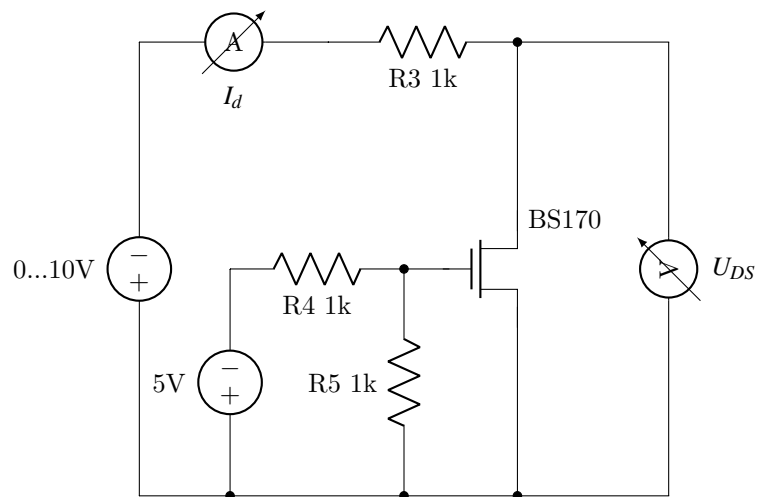
Rysunek 3: Układ do badania charakterystyki bramkowej tranzystora nMOS



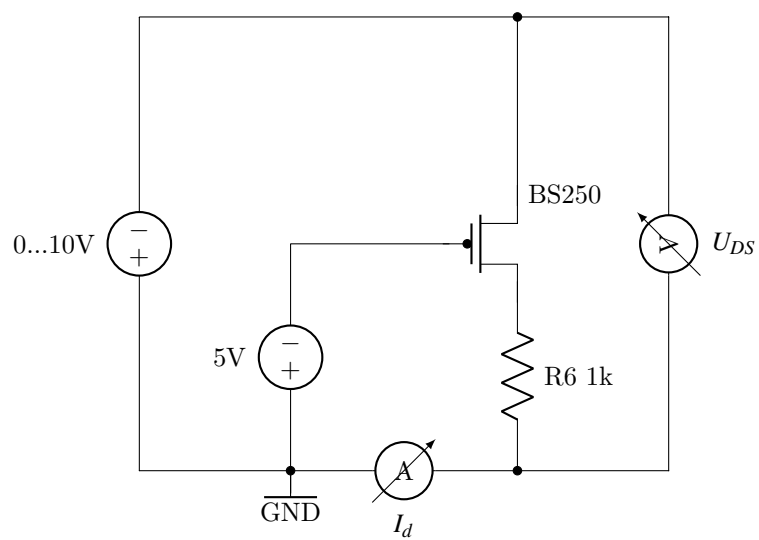
Rysunek 4: Układ do badania charakterystyki bramkowej tranzystora pMOS



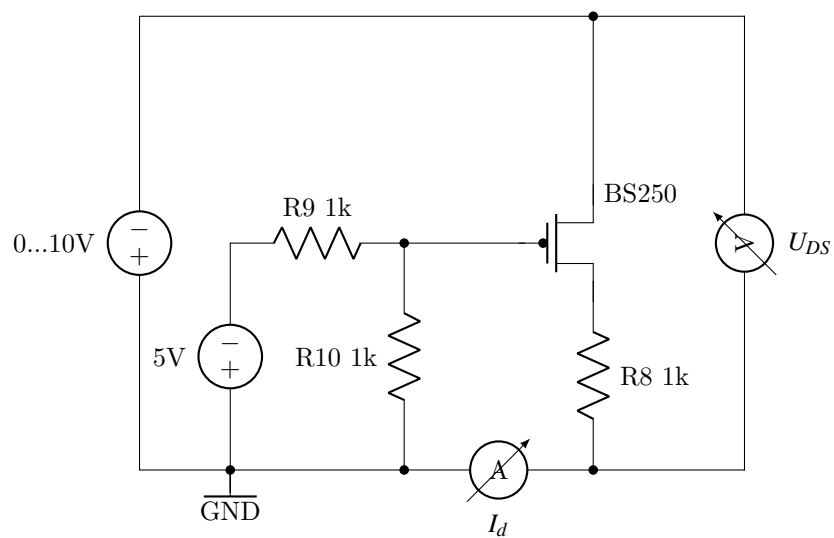
Rysunek 5: Układ do badania charakterystyki drenowej tranzystora nMOS



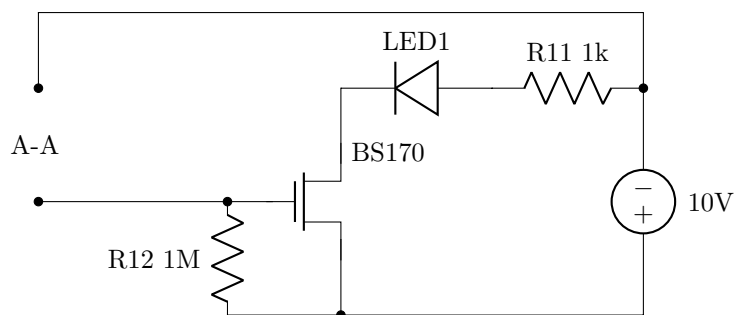
Rysunek 6: Układ do badania charakterystyki drenowej dla obniżonego napięcia bramki



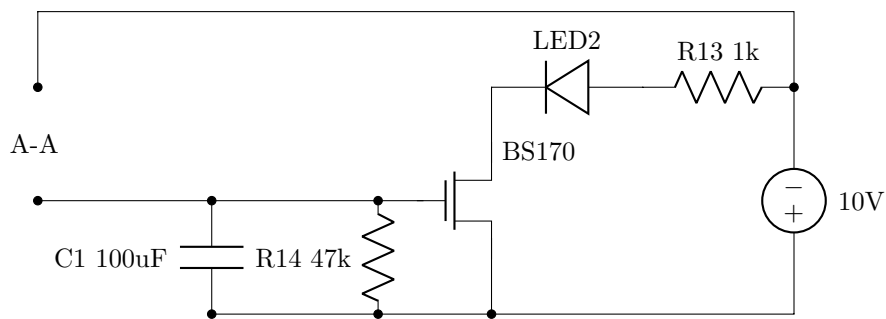
Rysunek 7: Układ do badania charakterystyki drenowej tranzystora pMOS



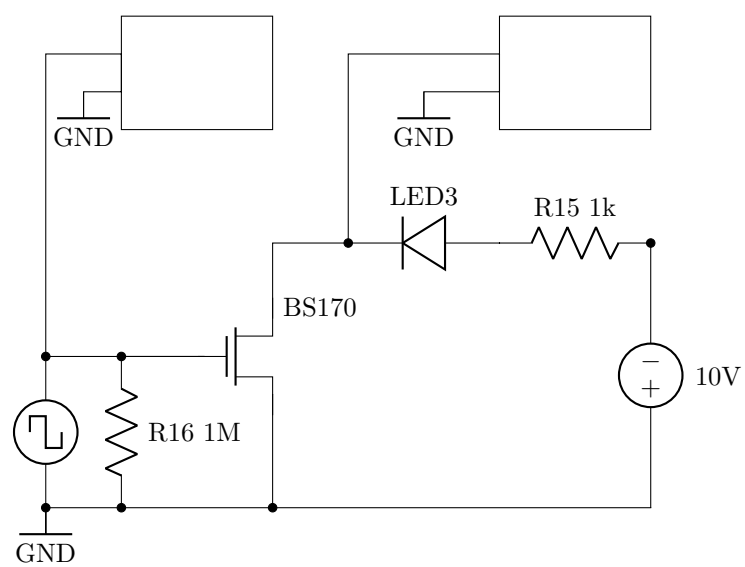
Rysunek 8: Układ do badania charakterystyki drenowej dla obniżonego napięcia bramki pMOS



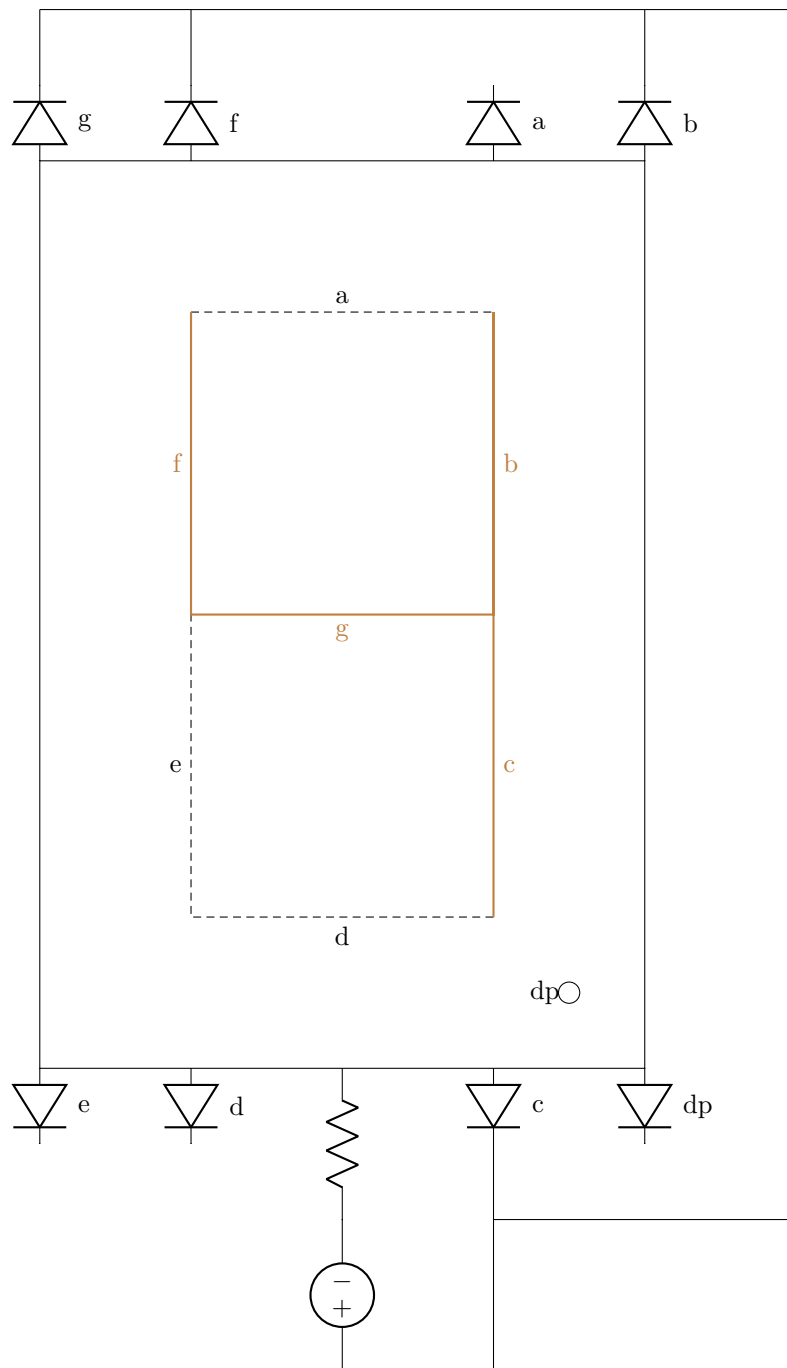
Rysunek 9: Schemat układu do badania tranzystora nMOS w roli przełącznika



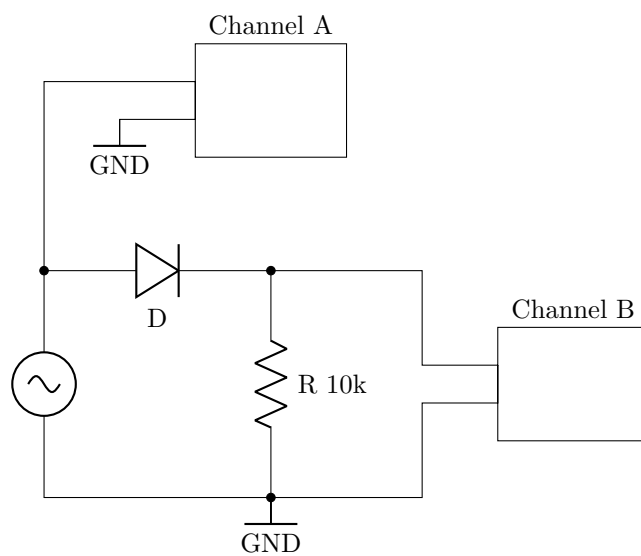
Rysunek 10: Model układu z opóźnieniem wyłączenia



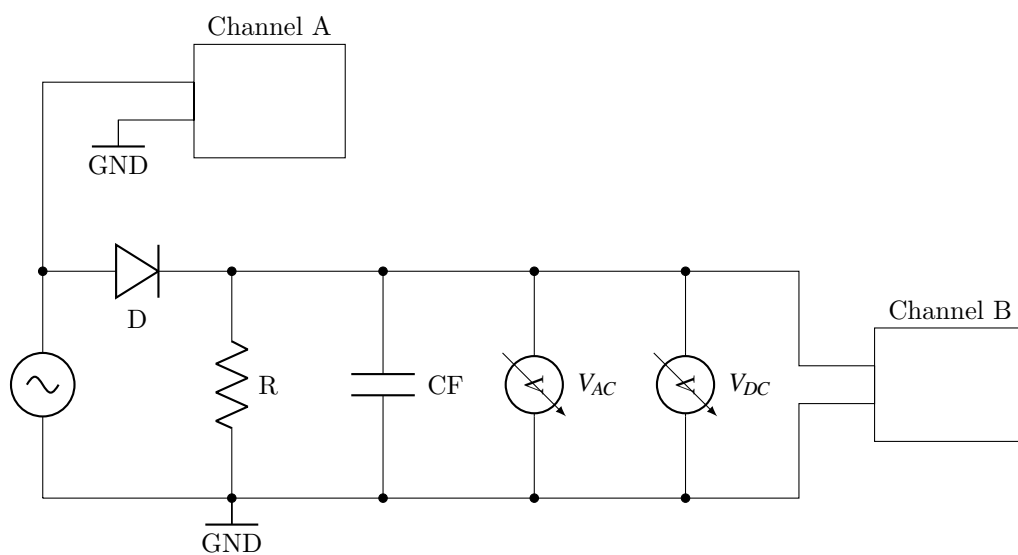
Rysunek 11: Obwód do pomiaru czasu przełączenia



Rysunek 12: Schemat połączeń wyświetlacza generującego cyfrę 4

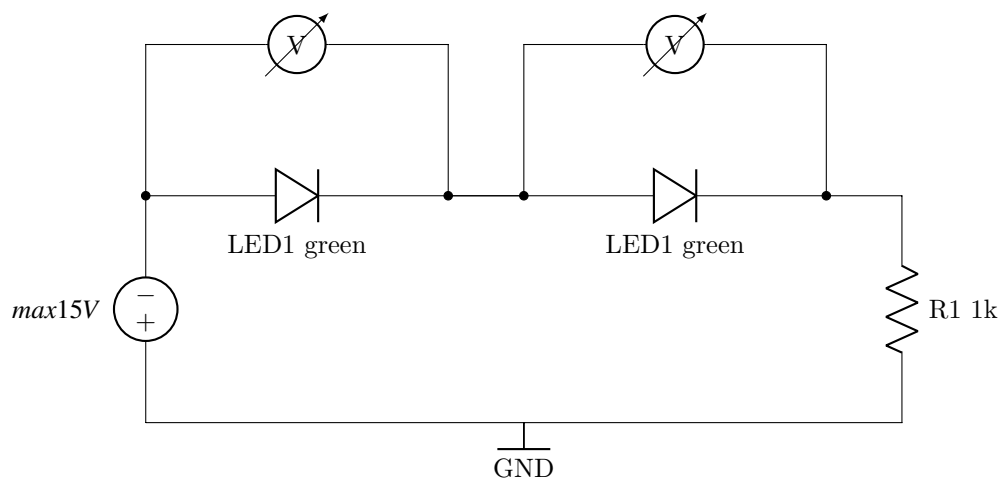


Rysunek 13: Układ pomiarowy dla badania własności prostownika jednopółprzewodnikowego

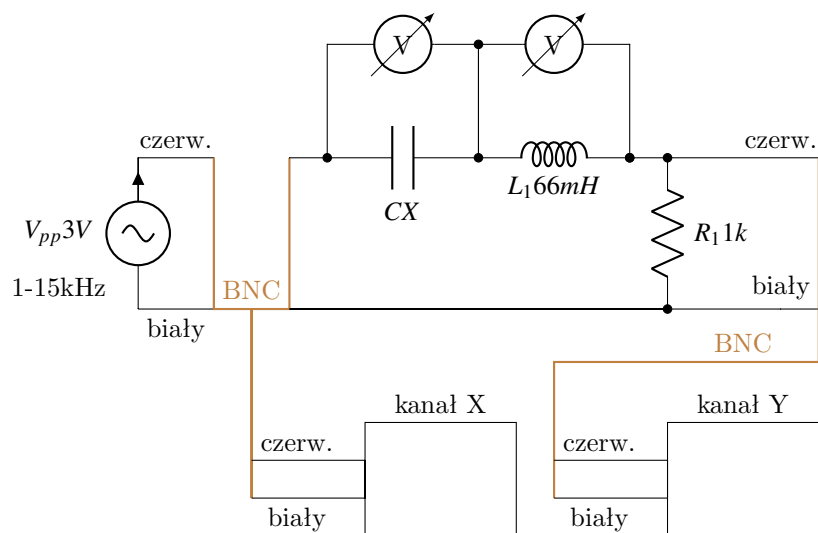


Rysunek 14: Układ prostownika jednopółprzewodnikowego z filtracją

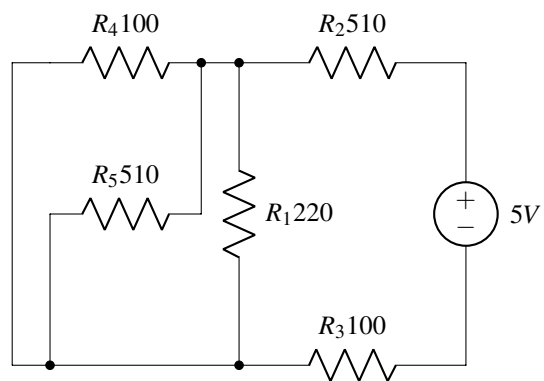




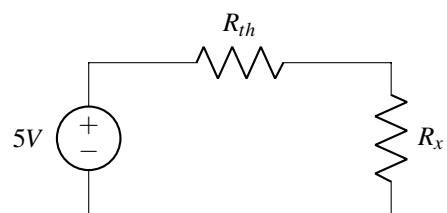
Rysunek 15: Schemat układu pomiarowego do badania diod świecących



Rysunek 16: tym razem nie tag



Rysunek 17: tag



Rysunek 18: dobrze mu jednak dać co mamy na myśli z  $r_{th}$  i  $r_x$